



2SC2785 (3DG2785)

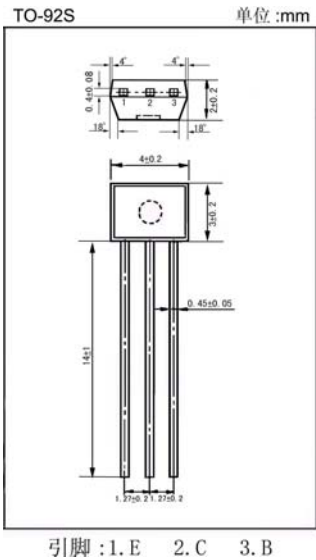
硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于音频放大器驱动级及低速开关/Purpose: Driver stage of AF amplifier and low speed switching.

特点:耐压高, 极好的线性, 可与 2SA1175 (3CG1175) 互补/Features: High voltage, excellent h_{FE} linearity, complementary pair with 2SA1175 (3CG1175).

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	60	V
V_{CE0}	50	V
V_{EB0}	5.0	V
I_C	100	mA
I_B	20	mA
P_C	250	mW
T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
I_{CB0}	$V_{CB}=60\text{V}$ $I_E=0$			0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=5.0\text{V}$ $I_C=0$			0.1	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=6.0\text{V}$ $I_C=1.0\text{mA}$	110		600	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=6.0\text{V}$ $I_C=0.1\text{mA}$	50			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}$ $I_B=10\text{mA}$		0.15	0.3	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}$ $I_B=10\text{mA}$		0.86	1.0	V
V_{BE}	$V_{CE}=6.0\text{V}$ $I_C=1.0\text{mA}$	0.55	0.62	0.65	V
f_T	$V_{CE}=6.0\text{V}$ $I_C=10\text{mA}$	150	250	450	MHz
C_{ob}	$V_{CB}=6.0\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		3.0	4.0	pF
NF	$V_{CE}=6.0\text{V}$ $I_C=0.1\text{mA}$ $R_g=2.0\text{K}\Omega$ $f=1.0\text{KHz}$		0.8	15	dB

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ classifications: R:110~180 J:135~220 H:170~270
F:200~320 E:250~400 K:300~600

